

DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for use as R.F., I.F. or A.F. amplifier
 DIODE-PENTHODE à pente variable pour l'utilisation en amplificatrice H.F., M.F. ou B.F.
 DIODE-PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als HF-, ZF- oder NF-Verstärker

Heating : indirect by A.C. or D.C.;
 series supply

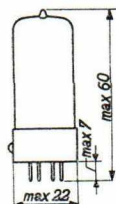
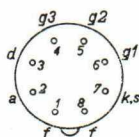
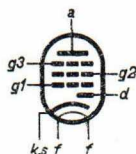
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;
 alimentation série

Heizung : indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom;
 Serienspeisung

$V_f = 12,6 \text{ V}$

$I_f = 100 \text{ mA}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Rimlock

Capacitances
 Capacités
 Kapazitäten

Pentode section
 Partie penthode
 Pentodenteil

Diode section
 Partie diode
 Diodenteil

$C_a = 5,2 \text{ pF}$

$C_{g1} = 4,1 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,002 \text{ pF}$

$C_{g1f} < 0,05 \text{ pF}$

$C_d = 3,3 \text{ pF}$

$C_{df} < 0,02 \text{ pF}$

Between diode and pentode sections
 Entre les parties diode et penthode
 Zwischen Dioden- und Pentodenteil

$C_{dg1} < 0,0015 \text{ pF}$

$C_{da} < 0,15 \text{ pF}$

Operating characteristics of the pentode section as R.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode en amplificatrice H.F. ou M.F.

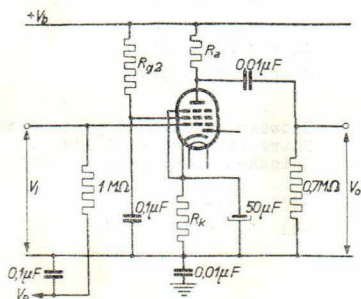
Betriebsdaten des Pentodenteiles als HF- oder ZF-Verstärker

$V_a = V_b =$	100	170	200	V
$V_{g3} =$	0	0	0	V
$R_{g2} =$	56	56	76	k Ω
$R_k =$	310	310	310	Ω
$V_{g1} =$	-1,2	-2	-2	V
	-16	-28	-34	
$V_{g2} =$	50	85	85	V
$I_a =$	2,8	5,0	5,0	mA
$I_{g2} =$	0,9	1,5	1,5	mA
$S =$	1700	2000	2000	$\mu A/V$
	17	20	20	
$R_i =$	0,85	0,9	1,0	M Ω
	>10	>10	>10	
$\mu_{g2g1} =$	16	16	16	
$R_{eq} =$	5,8	7,5	7,5	k Ω

Operating characteristics of the pentode section as resistance coupled A.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode en amplificatrice B.F. à couplage par résistance

Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF-Verstärker mit Widerstandskopplung



This valve can be used without special precautions against microphonic effect in circuits in which the input voltage $V_i \geq 10$ mV for an output of 50 mW of the output valve

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits dont la tension d'entrée $V_i \geq 10$ mV pour une puissance de 50 mW du tube de sortie

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen die für eine Eingangsspannung $V_i \geq 10$ mV eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben

A. $V_b = 170$ V; $R_a = 0,22$ M Ω ; $R_{g2} = 0,82$ M Ω ; $R_k = 2,7$ k Ω

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	d_{tot} (%) ($V_o=3V_{eff}$)	d_{tot} (%) ($V_o=5V_{eff}$)	d_{tot} (%) ($V_o=8V_{eff}$)
0	0,50	0,17	80	0,8	1,0	1,2
5	0,38	0,12	23	1,5	2,5	4,0
10	0,28	0,09	14	1,9	3,2	5,0
15	0,20	0,06	9	2,6	4,2	6,5
20	0,14	0,04	6	3,6	6,0	9,0

B. $V_b = 170$ V; $R_a = 0,1$ M Ω ; $R_{g2} = 0,33$ M Ω ; $R_k = 1,5$ k Ω

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	d_{tot} (%) ($V_o=3V_{eff}$)	d_{tot} (%) ($V_o=5V_{eff}$)	d_{tot} (%) ($V_o=8V_{eff}$)
0	1,05	0,37	68	0,75	0,8	1,1
5	0,71	0,25	20	2,2	3,2	5,0
10	0,48	0,17	10	2,4	3,7	5,5
15	0,30	0,11	6	3,0	4,5	7,0
20	0,16	0,07	3,5	5,2	8,0	12

C. $V_b = 100$ V; $R_a = 0,22$ M Ω ; $R_{g2} = 0,82$ M Ω ; $R_k = 2,7$ k Ω

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	d_{tot} (%) ($V_o=3V_{eff}$)	d_{tot} (%) ($V_o=5V_{eff}$)
0	0,29	0,09	75	0,9	1,1
2,5	0,22	0,07	27	2,6	4,4
5	0,17	0,05	15	3,2	5,0
7,5	0,13	0,04	10	4,0	6,5
10	0,10	0,03	7	5,2	8,0

D. $V_b = 100 \text{ V}$; $R_a = 0,1 \text{ M}\Omega$; $R_{g2} = 0,33 \text{ M}\Omega$; $R_k = 1,5 \text{ k}\Omega$

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	$d_{tot} (\%)$ ($V_o = 3V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o = 5V_{eff}$)
0	0,58	0,21	60	0,9	1,0
2,5	0,43	0,14	25	2,3	4,5
5	0,31	0,10	12	3,5	6,0
7,5	0,21	0,07	7,5	4,7	8,0
10	0,14	0,05	5	7,0	11,0

Limiting values of the pentode section

Caractéristiques limites de la partie penthode

Grenzdaten des Pentodenteiles

V_{a0}	= max.	550 V
V_a	= max.	250 V
W_a	= max.	2 W
V_{g20}	= max.	550 V
$V_{g2} (I_a < 2,5 \text{ mA})$	= max.	250 V
$V_{g2} (I_a = 5 \text{ mA})$	= max.	125 V
W_{g2}	= max.	0,3 W
I_k	= max.	10 mA
$V_{g1} (I_{g1} = +0,3 \text{ }\mu\text{A})$	= max.	-1,3 V
R_{g1}	= max.	3 M Ω
R_{g3}	= max.	3 M Ω
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	150 V

Limiting values of the diode section

Caractéristiques limites de la partie diode

Grenzdaten des Diodenteiles

V_{ainvp}	= max.	350 V
I_d	= max.	0,8 mA
I_{dp}	= max.	5 mA
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	150 V